



汕头华汕电子器件有限公司

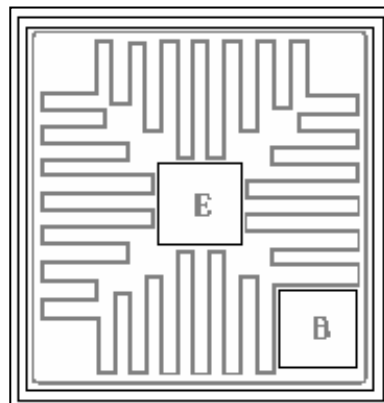
NPN SILICON TRANSISTOR

2328S 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：C089BJ-01
芯片厚度： $240 \pm 20\mu\text{m}$
管芯尺寸： $890 \times 890\mu\text{m}^2$
焊位尺寸：B 极 $150 \times 150\mu\text{m}^2$ ；E 极 $153 \times 153\mu\text{m}^2$
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：KSC2328A，H2328S

管芯示意图



极限值 ($T_a=25$) (封装形式：TO-92)

T_{stg} ——贮存温度..... -55~150
 T_j ——结温..... 150
 P_C ——集电极耗散功率..... 0.75W
 V_{CBO} ——集电极—基极电压..... 30V
 V_{CEO} ——集电极—发射极电压..... 30V
 V_{EBO} ——发射极—基极电压..... 5V
 I_C ——集电极电流..... 2A

电参数 ($T_a=25$) (封装形式：TO-92)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	30			V	$I_C=100\mu\text{A}$ ， $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	30			V	$I_C=10\text{mA}$ ， $I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	5			V	$I_E=1\text{mA}$ ， $I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			100	nA	$V_{\text{CB}}=30\text{V}$ ， $I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			100	nA	$V_{\text{EB}}=5\text{V}$ ， $I_C=0$
h_{FE}	直流电流增益	100		320		$V_{\text{CE}}=2\text{V}$ ， $I_C=500\text{mA}$
$V_{\text{CE}}(\text{sat})$	集电极—发射极饱和电压			2	V	$I_C=1.5\text{A}$ ， $I_B=30\text{mA}$
$V_{\text{BE}}(\text{on})$	基极—发射极导通电压			1	V	$V_{\text{CE}}=2\text{V}$ ， $I_C=500\text{mA}$
f_T	特征频率		120		MHz	$V_{\text{CE}}=2\text{V}$ ， $I_C=500\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容		30		pF	$V_{\text{CB}}=10\text{V}$ ， $I_E=0$ ， $f=1\text{MHz}$